

하이닉스, STT-M램 2015년 출시

일본 도시바와 공동개발 ... 10나노급 초미세공정의 차세대 메모리

SK하이닉스 차세대 메모리인 STT-M램의 첫 상용제품을 2015년 출시할 계획이라고 4월26일 발표했다.

STT-M램은 일본 도시바(Toshiba)와 공동 개발하고 있다.

STT-M램은 D램과 낸드플래시의 특성을 모두 가지면서 10나노급 이하 초미세 공정으로 회로집적이 가능해 차세대 메모리로 주목받고 있다.

그러나 D램과 낸드 기술이 계속 발전하고 원가를 절감한다면 STT-M램이 시장에 나오는 시점이 더 늦어질 것으로 예상된다.

SK하이닉스는 자동차에 적용할 수 있는 메모리를 자동차기업과 공동으로 개발하고 있으며 자동차용 반도체를 핵심사업으로 육성할 방침이다.

SK하이닉스는 2012년 4조2000억원의 설비투자 가운데 55%를 낸드플래시에, 나머지 45%는 D램에 투자할 계획이다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2012/04/26>